

請求の範囲

- [請求項1] 基板上に局所的に配された導体部が、フィラーをなす無機部材が有機部材に分散してなる樹脂部によって被覆された構成を含む配線基板の加工方法であって、
- アッシング法を用い、前記樹脂部の表層側から前記有機部材を除去し、
- ウェット洗浄法を用い、前記有機部材が除去された樹脂部の表層側に残存する前記無機部材を除去する、
- 配線基板の加工方法。
- [請求項2] 前記樹脂部の表層側からの前記有機部材の除去は、前記導体部を覆う位置にある樹脂部を通して、該導体部の表層部が観測されるまで繰り返し行われる、
- 請求項1に記載の配線基板の加工方法。
- [請求項3] 前記樹脂部の表層側からの前記有機部材の除去に用いられるアッシング法は、前記基板に対して高周波電力を印加しながら行われ、高周波電力のバイアスRF出力[W]が0～1500である、
- 請求項1又は請求項2に記載の配線基板の加工方法。
- [請求項4] 前記樹脂部の表層側からの前記有機部材の除去に用いられるアッシング法は、前記基板に対して高周波電力を印加しながら行われ、高周波電力のバイアスRF出力密度[W/cm²]が0.2～0.8である、
- 請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の配線基板の加工方法。
- [請求項5] 前記樹脂部の表層側からの前記有機部材の除去に用いられるアッシング法は、プロセスガスとして酸素(O₂)、窒素(N₂)、四フッ化炭素(CF₄)からなる群より選択されるガスを含む混合ガスを用いる、
- 請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の配線基板の加工方法。

-
- [請求項6] 前記無機部材の除去により表層部が露呈された導体部に少なくとも一部が重なるように、積層構造における導体部の形成に用いられる下地としてシード層を形成し、
前記シード層の表面プロファイルを測定することにより、前記露呈した導体部の表面と、該導体部を取り囲む樹脂部の表面とが面一を成しているか否かを評価する、
請求項 1 から請求項 5 のいずれか一項に記載の配線基板の加工方法
-